## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Mai 2002 (30.05.2002)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/43243 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: H03H 9/58

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/12825

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. November 2001 (06.11.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 58 339.3 24. November 2000 (24.11.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): AIGNER, Robert [AT/DE]; Einsteinstr. 104/8-13, 81675 München (DE). MARKSTEINER, Stephan [AT/DE]; Cramer-Klett-Strasse 33, 85579 Neubiberg (DE). **NESSLER, Winfried** [AT/DE]; Ulrich von Huttenstrasse 24, 81739 München (DE). **ELBRECHT, Lüder** [DE/DE]; Theodor-Dombart-Strasse 1, 80805 München (DE).

(74) Anwälte: GINZEL, Christian usw.; Zimmermann & Partner, Postfach 330 920, 80069 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

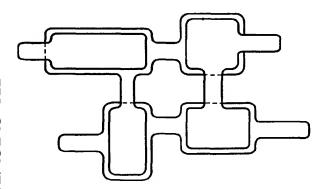
— mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
Frist; Ver\(\tilde{O}\)flentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: BULK ACOUSTIC WAVE FILTER

(54) Bezeichnung: BULK-ACOUSTIC-WAVE-FILTER



(57) Abstract: The invention relates to bulk acoustic wave filters comprising at least two bulk acoustic wave resonators, each of these comprising at least one first electrode, a piezo-electric layer and a second electrode. At least two of the bulk acoustic wave resonators have effective resonator surfaces which differ in their surface form and/or surface content. The inventive design of the bulk acoustic wave resonators enables optimal suppression of interference modes without influencing the impedance level of the filter.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben werden Bulk-Acoustic-Wave-Filter mit wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste

Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch die beschriebene Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau des Filters beeinflusst wird.





1

Beschreibung

Bulk-Acoustic-Wave-Filter

5

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft Bulk-Acoustic-Wave-Filter.

Elektrische Filter, die aus Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter aufgebaut sind, werden üblicherweise als Bulk-Acoustic-Wave-Filter bezeichnet.

Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren bestehen typischerweise aus zwei Elektroden und einer piezoelektrischen Schicht, die zwischen den beiden Elektroden angeordnet ist. Ein solcher Stapel aus Elektrode 1 / Piezoschicht / Elektrode 2 wird auf einem Träger angeordnet, der die akustische Welle reflektiert (M. Kenneth, G. R. Kline, K. T. McCarron, High-Q Microwave Acoustic Resonatores and Filters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 41, No. 12, 1993).

Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Bulk-Acoustic-Wave-Resonator. Grundsätzlich wäre die Verwendung einer Konfiguration ausschließlich bestehend aus Elektrode 1 / Piezoschicht 3 / Elektrode 2 erstrebenswert. Allerdings weist eine solche Anordnung eine zu geringe Stabilität auf. Daher wird die Anordnung auf ein Substrat 4 aufgebracht, was aber mit dem Nachteil verbunden ist, dass die Schallwellen in das Substrat 4 eindringen und dadurch Störungen verursacht werden. Das Substrat 4 sollte also neben einer mechanischen Trägerfunktion gleichzeitig eine möglichst gute akustische Isolation bereitstellen. Die Figur 1 zeigt einen akustischen Spiegel, der aus einem Substrat 4 und einer Abfolge von zwei low-Z- 5 und zwei high-Z- 6 Schichten besteht.

35

Stacked-Crystal-Filter bestehen im allgemeinen aus zwei piezoelektrischen Schichten und drei Elektroden. Diese

2

insgesamt fünf Elemente bilden eine Sandwich-Struktur, wobei jeweils eine piezoelektrische Schicht zwischen zwei Elektroden angeordnet ist. Die mittlere der drei Elektroden wird dabei in der Regel als Erdungselektrode verwendet.

5

10

15

20

25

30

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch einen Stacked-Crystal-Filter. Der Stacked-Crystal-Filter besteht aus einem Substrat 7, einer Membran 8, einer ersten, unteren Elektrode 9, einer ersten, unteren piezoelektrischen Schicht 10, einer zweiten, oberen piezoelektrischen Schicht 11, einer zweiten mittleren Elektrode 12 und einer dritten, oberen Elektrode 13. Die mittlere Elektrode 12 ist über einem Teil der unteren piezoelektrischen Schicht 10 und der Membran 8 angeordnet. die obere piezoelektrische Schicht 11 ist über Teilen der mittleren Elektrode 12 und der unteren piezoelektrischen Schicht 10 angeordnet und die dritte, obere Elektrode 13 ist über der oberen piezoelektrischen Schicht 11 angeordnet. Die zweite Elektrode 12 dient als Erdungselektrode. Das Substrat 7 weist einen Hohlraum 14 auf, der dazu dient, die akustischen Schwingungen der piezoelektrischen Schichten zu reflektieren.

Die Reflexion der akustischen Schwingungen wird somit entweder mit Hilfe eines akustischen Spiegels oder mit Hilfe eines Hohlraums erreicht. Ein akustischer Spiegel wurde oben im Zusammenhang mit einem Bulk-Acoustic-Wave-Resonator beschrieben, während die Reflexion der akustischen Schwingungen durch einen Hohlraum für einen Stacked-Crystal-Filter gezeigt wurde. Selbstverständlich ist aber auch die umgekehrte Kombination möglich, also ein Bulk-Acoustic-Wave-Resonator mit einem Hohlraum im Substrat genauso wie ein Stacked-Crystal-Filter mit einem akustischen Spiegel.

Die piezoelektrischen Schichten sind in der Regel aus
35 Aluminiumnitrid aufgebaut. Als Material für die Elektroden
werden häufig Aluminium, Aluminium-enthaltende Legierungen,
Wolfram, Molybdän oder Platin verwendet. Als Substratmaterial

3

kann z.B. Silizium, Galliumarsenid, Glas oder eine Folie verwendet werden.

Wie oben bereits erläutert weist jeder Bulk-Acoustic-5 Wave-Resonator oder Stacked-Crystal-Filter wenigstens zwei Elektroden auf. Die Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf zwei übereinander gelagerte Elektroden, nämlich eine untere Elektrode 15 und eine obere Elektrode 16. Die beiden Elektroden können jede beliebige geometrische Form aufweisen. Als "effektive Resonatorfläche" wird im Rahmen der 10 vorliegenden Erfindung die Fläche der Elektroden bezeichnet, die sich bei einer Projektion der beiden Elektroden in eine Ebene als der überlappende Bereich der Elektroden ergibt. Die effektive Resonatorfläche der Elektroden 15 und 16 ist in 15 Fig. 3 schraffiert dargestellt. Aufgrund der grundsätzlich beliebigen Form der Elektroden 15 und 16 ergibt sich für die effektive Resonatorfläche eine beliebig geformte ebene Fläche.

Jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator weist somit eine bestimmte effektive Resonatorfläche auf, die durch ihre geometrische Form und durch ihren Flächeninhalt gekennzeichnet ist. Zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren mit unterschiedlicher effektiver Resonatorfläche können sich also grundsätzlich in der Flächenform der effektiven Resonatorfläche und/oder im Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche unterscheiden.

Ein Bulk-Acoustic-Wave-Filter setzt sich aus einer

Mehrzahl von parallel bzw. in Reihe geschalteten BulkAcoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter
zusammen. Im folgenden wird der Begriff "Bulk-Acoustic-WaveResonator" synonym für die beiden, in den Figuren 1 und 2
gezeigten, Vorrichtungen, nämlich Bulk-Acoustic-WaveResonator und Stacked-Crystal-Filter, gebraucht.

4

Das Design der Bulk-Acoustic-Wave-Filter wird in der Regel derart gestaltet, dass die in Serie geschalteten Resonatoren eine serielle Resonanz aufweisen, deren Frequenz möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht, während entsprechend die parallel geschalteten Resonatoren eine parallele Resonanz aufweisen, deren Frequenz ebenfalls möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht.

5

Acoustic-Wave-Filtern stellen die Störmoden der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren, aus denen die Filter aufgebaut
sind, dar. Diese Störmoden führen zu Störspitzen in der
elektrischen Impedanzkurve der Bulk-Acoustic-Wave15 Resonatoren, die sich in weiterer Folge auch auf den
Durchlassbereich der Filter nachteilig auswirkt. Vor allem
wird das Stehwellenverhältnis verschlechtert bzw. die
Phasenkurve der Filter verzerrt, wodurch z.B. in ReceiverFrontends die Bedingung konstanter Gruppenlaufzeit innerhalb
20 eines Sendekanals verletzt wird.

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Ansätze bekannt, mit denen eine Unterdrückung der Störmoden versucht wird. Die US 5,903,087 offenbart Bulk-Acoustic-Wave25 Resonatoren, deren Elektroden an den Rändern nicht geglättet sind, sondern vielmehr in Form eines Zufallsmusters angerauhte Ränder aufweisen, wobei die Rauhigkeit ungefähr die Dimension der Wellenlängen der Störmoden aufweist. Die Störmoden werden dadurch unterdrückt und sind in der
30 Impedanzkurve weniger sichtbar. Allerdings treten bei diesem Verfahren starke Energieverluste auf, die sich auf die Güte der Hauptresonanzen auswirken.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 35 zugrunde, Bulk-Acoustic-Wave-Filter zur Verfügung zu stellen, bei denen die Störmoden gedämpft werden, aber gleichzeitig

5

die Nutzresonanz nur unwesentlich oder überhaupt nicht beeinflusst wird.

Diese Aufgabe wird durch den Bulk-Acoustic-Wave-Filter gemäß unabhängigem Patentanspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen, Ausgestaltungen und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen.

10

15

20

25

30

35

5

Der erfindungsgemäße Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfasst wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch diese Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau des Filter beeinflusst wird.

Da jeder Resonator andere Störmodenfrequenzen aufweist, kommt es durch die Verschaltung im Filter zu einem Mittelungseffekt. Dadurch macht sich die einzelne Störmode im Filterresponse im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Bulk-Acoustic-Wave-Filtern mit Resonatoren gleicher Fläche nicht so stark bemerkbar. Allerdings beeinflussen unterschiedliche Flächeninhalte der effektiven Resonatorflächen auch das Impedanzniveau der Resonatoren. Sie sind daher durch Impedanzanpassbedingungen im Filter in einem gewissen Rahmen festgelegt.

Sämtliche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beruhen also darauf, dass nicht versucht wird, den einzelnen Bulk-Acoustic-Wave-Resonator störmodenfrei zu machen, was technisch schwierig ist und möglicherweise Resonator-Perfomance kostet, sondern darauf, dass erst mit der

6

Verschaltung im Filter eine Verwaschung von vielen Störmoden bei unterschiedlichen Frequenzen eintritt und damit die Transmissionsfunktion des Filters den erwünschten glatten Verlauf erhält.

5

10

15

20

25

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren des Bulk-Acoustic-Wave-Filters effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Aspektverhältnis auf. Das Aspektverhältnis beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie sie durch den Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren beeinflusst wird, verändert aber das Impedanzniveau nicht. Die Störmoden werden somit wirkungsvoll unterdrückt, wobei gleichzeitig die Nutzresonanz unverändert bleibt.

Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspekt-Verhältnissen aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Ebenfalls bevorzugt wird eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemäß der wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Unter einer nicht-rechtwinkligen Form der effektiven Resonatorfläche eines Bulk-Acoustic-Wave-Resonators wird eine Form verstanden, bei der die Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorfläche ungleich 90° sind. Durch diese Ausgestaltung

7

der Resonatoren gelingt eine gute Unterdrückung der Störmoden.

Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Beste Resultate lassen sich mit Bulk-Acoustic-WaveFiltern erzielen, bei denen wenigstens zwei der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit
unterschiedlichem Flächeninhalt und gleichzeitig
unterschiedlichem Aspektverhältnis aufweisen. Durch passende
Wahl des Flächeninhalts der effektiven Resonatorfläche und
gleichzeitige Variation des Aspektverhältnisses der
effektiven Resonatorfläche lassen sich sowohl
Impedanzanpassungsbedingungen erfüllen als auch Störmoden
optimal unterdrücken.

20

25

30

5

Eine weitere Verbesserung wird mit Ausführungsformen erzielt, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten und unterschiedlichen Aspektverhältnissen aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Ebenfalls bevorzugt werden Bulk-Acoustic-Wave-Filter, wobei wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Aspektverhältnis und gleichzeitig nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen

8

und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, gemäß denen wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eines Bulk-Acoustic-Wave-Filters eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Flächeninhalt, unterschiedlichen Aspektverhältnis und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

10

15

20

25

30

35

5

Ebenfalls besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten, unterschiedlichen Aspektverhältnissen und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Besonders gute Störmodenunterdrückung wird erreicht, wenn das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorflächen der erfindungsgemäßen Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren zwischen 1:1 und 1:5 liegt, insbesondere zwischen 1:1.5 und 1:3.

Weisen die effektiven Resonatorflächen der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren unterschiedlichen Flächeninhalt
auf, so wird bevorzugt, dass sich der Flächeninhalt der
effektiven Resonatorflächen um wenigstens 5 % voneinander
unterscheidet, insbesondere um wenigstens 10 %. Ganz
besonders bevorzugt wird, dass sich der Flächeninhalt der
effektiven Resonatorflächen um wenigstens 20 % voneinander
unterscheidet, insbesondere um wenigstens 50 %.

Die Bulk-Acoustic-Wave-Filter werden durch Verschaltung von Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren hergestellt. Das Prinzip, den Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche, das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorfläche und/oder den Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen zu variieren, um Störmoden im Filterresponse

WO 02/43243

25

zu unterdrücken, lässt sich auf jede Filtertopologie anwenden. Gemäß besonders bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erfolgt die Verschaltung in Form eines 1½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 3-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters, wobei 3, 4, 5, 6 oder 7 Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren verschaltet werden.

9

PCT/EP01/12825

10 Ebenfalls bevorzugt wird die Verschaltung der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren zu einem Bulk-Acoustic-Wave-Filter
in Form eines 1-stufigen balanced Filters, in Form eines 2stufigen balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen
balanced Filters. Es werden in diesem Fall 4, 8 oder 12 Bulk15 Acoustic-Wave-Resonatoren verschaltet.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 8 näher dargestellt. Es zeigen:

20	Fig.	1	einen	aus	dem	Stand	der	Technik	bekannten	
			Bulk-Acoustic-Wave-Resonator:							

- Fig. 2 einen aus dem Stand der Technik bekannten Stacked-Crystal-Filter;
- Fig. 3 zwei übereinandergelagerte Elektroden und deren effektive Resonatorfläche;
- Fig. 4 einen aus dem Stand der Technik bekannten 2-30 stufigen Leiterfilter;
- Fig. 5 einen erfindungsgemäßen 2-stufigen Leiterfilter aufgebaut Bulk-Acousticaus Wave-Resonatoren mit unterschiedlichem 35 Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen;

10

- Fig. 6 einen erfindungsgemäßen 2-stufigen
  Leiterfilter aufgebaut aus Bulk-AcousticWave-Resonatoren mit unterschiedlichem
  Aspektverhältnis der effektiven
  Resonatorflächen;
- Fig. 7 Auftragung (schematisch) des Streuparameters von Eingang zu Ausgang  $(S_{12})$  gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 identischen quadratischen Einzelresonatoren (Stand der Technik);

5

- Fig. 8 Auftragung (schematisch) des Streuparameters von Eingang zu Ausgang  $(S_{12})$  gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 Einzelresonatoren mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen der effektiven Resonatorflächen (Erfindung).
- Fig. 4 zeigt einen aus dem Stand der Technik bekannten 2-stufigen Leiterfilter mit 4 gleich großen quadratischen Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, die eine identische effektive Resonatorfläche aufweisen. Die Störmoden jedes Einzelresonators treten an den gleichen Frequenzstellen auf und sind entsprechend im elektrischen Response des Filters zu finden.
- Fig. 5 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 BulkAcoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen,

  30 die unterschiedliche Flächeninhalte aufweisen. Jeder
  Resonator hat unterschiedliche Störmodenfrequenzen. Durch die
  Verschaltung im Filter kommt es zu einem Mittelungseffekt,
  wodurch sich die einzelne Störmode im Filterresponse im
  Vergleich zu der in Fig. 4 gezeigten Ausführungform des

  35 Standes der Technik nicht so stark bemerkbar macht.

11

Fig. 6 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 BulkAcoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen,
die zwar gleichen Flächeninhalt, aber unterschiedliche
Aspektverhältnisse aufweisen. Das Aspektverhältnis
beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie bei
der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform, wobei aber
gleichzeitig das Impedanzniveau des Filters unverändert
bleibt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen jeweils eine schematische Auftragung des Streuparameters von Eingang zu Ausgang  $S_{12}$  in logarithmischer Skala gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 Einzelresonatoren. Zur Bestimmung von  $S_{12}$  wurde in bekannter Weise durch einen Frequenzanalysator die Streumatrix des Leiterfilters ermittelt.

In der Fig. 7 ist die Kennlinie eines aus dem Stand der Technik bekannten Leiterfilters, der aus 6 gleichen quadratischen Einzelresonatoren mit identischen effektiven Resonatorflächen besteht, dargestellt. Die Kennlinie zeigt ein "Rauschen" im Passband, das von spurious modes der Einzelresonatoren verursacht ist.

20

25

30

35

In der Fig. 8 ist die Kennlinie eines Leiterfilters gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt, der die gleiche Topologie aufweist wie der Leiterfilter, dessen Kennlinie in Fig. 7 dargestellt ist, allerdings weisen die effektiven Resonatorflächen der 6 Einzelresonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse auf. Das Rauschen im Passband mittelt sich aus der Kurve heraus, da die spurious modes der Einzelresonatoren an verschiedenen Frequenzpunkten auftreten.

Ähnliche Ergebnisse liefert ein Vergleich von einerseits Filtern mit Einzelresonatoren mit quadratischen effektiven Resonatorflächen und andererseits Filtern, bei denen die effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren nicht rechtwinklige Form aufweisen (Winkel zwischen den

12

Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren ungleich 90°). Hier wird ein deutlich geringeres Rauschen im Passband für den Filter festgestellt, dessen Einzelresonatoren effektive Resonatorflächen mit nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

\*

Patentansprüche

WO 02/43243

Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfassend wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst, dad urch gekennzeichnet, dass

13

PCT/EP01/12825

- dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen aufweisen, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
- Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1,
   d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive
   Resonatorflächen aufweisen, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
- 20 3. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren ein unterschiedliches Aspektverhältnis aufweisen.

25

4. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-WaveResonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse aufweisen.

30

5. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, dass

die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der

Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine nicht-rechtwinklige Form aufweisen.

14

6. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-WaveResonatoren eine nicht-rechtwinklige Form aufweisen.

5

10

15

7. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen zwischen 1:1 und 1:5 liegt.

- 8. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen zwischen 1:1.5 und 1:3 liegt.
- 9. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass 20 sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um wenigstens 5 % voneinander unterscheidet, insbesondere um wenigstens 10 %.

- 10.Bulk-Acoustic-Wave-Filter Anspruch 9,
- 25 dadurch gekennzeichnet, dass sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um wenigstens 20 % voneinander unterscheidet, insbesondere um wenigstens 50 %.
- 30 11.Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1½stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen

Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 3-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters verschaltet sind.

15

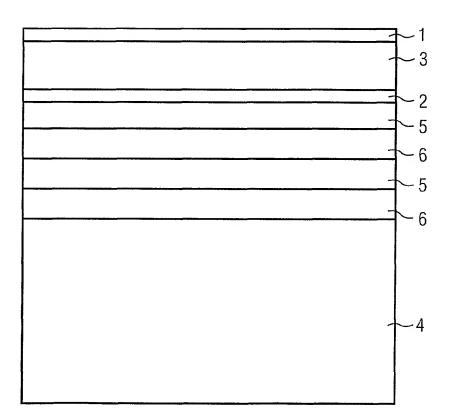
12.Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

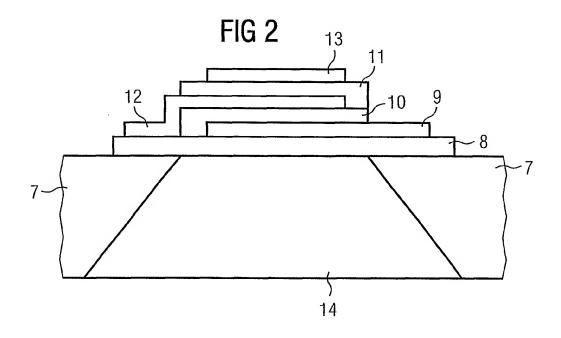
dadurch gekennzeichnet, dass die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1-stufigen balanced Filters, in Form eines 2-stufigen balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen balanced Filters verschaltet sind.

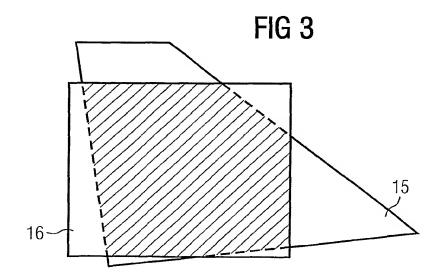
5

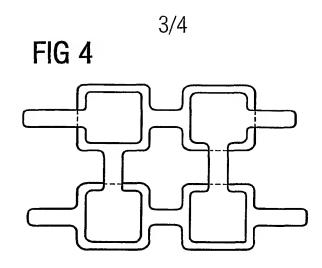
1/4

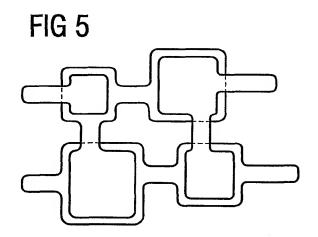
FIG 1

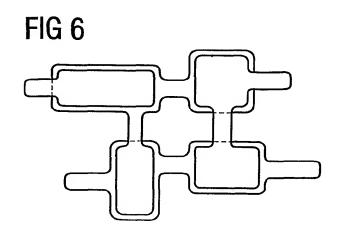




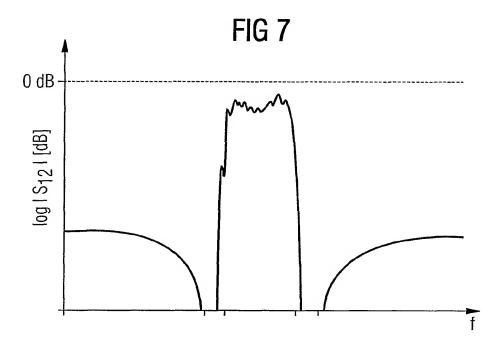


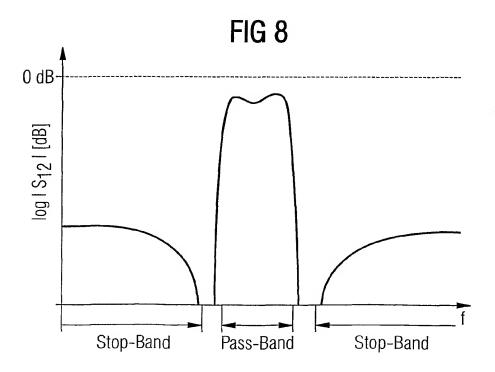






4/4





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tional Application No PCT/EP 01/12825

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H03H9/58						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED					
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification H03H	on symbols)				
110 /						
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	arched			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)				
EPO-In	ternal					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.			
х	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET 5 November 1996 (1996-11-05)	AL)	1-3,7,8			
Α	column 4, line 59 -column 5, line figures 4-6	28;	4,9,10			
	<del></del>					
Α	US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO) 23 February 1982 (1982-02-23) column 2, line 35,36 claim 35		4,5			
Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.			
° Special ca	tegories of cited documents:	"T' later document published after the inte	rnational filing date			
"A" docume	ent defining the general stale of the art which is not ered to be of particular relevance		eory underlying the			
"E" earlier o	document denning the general state or the art which is not considered to be of particular relevance citied to understand the principle or theory underlying the invention citied to understand the principle or theory underlying the invention citied to understand the principle or theory underlying the invention considered to be of particular relevance; the claimed invention					
"L" docume	thing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone					
citatio	which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to Involve an Inventive step when the					
	*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document is combined with one or more other such document is combined with the combined with the such docum					
	"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in the art.  **S** document member of the same patent family					
Date of the	Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report					
1	0 April 2002	19/04/2002				
Name and r	nailing address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Hijswijk Tel (+31-70) 340-2040 Tv 31 851 epo ni	0				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Coppieters, C				

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| Iη :ional Application No | PCT/EP 01/12825

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 5572173	A	05-11-1996	JP JP	7226651 A 7226652 A	22-08-1995 22-08-1995	
US 4317093	A	23-02-1982	CA JP	1153077 A1 55137712 A	30-08-1983 27-10-1980	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12825

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H03H9/58							
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK							
B. RECHER	ACHIERTE GEBIETE						
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H03H							
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Geble	ote fallen				
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendet	e Suchbegriffe)				
EPO-In	ternal						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		)				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
х	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET 5. November 1996 (1996-11-05)	1-3,7,8					
A	Spalte 4, Zeile 59 -Spalte 5, Zei Abbildungen 4-6	4,9,10					
A	US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO) 23. Februar 1982 (1982-02-23) Spalte 2, Zeile 35,36 Anspruch 35		4,5				
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen							
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist aber nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist ansternationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung beteigt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist der Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist anmeldeng nicht kollidlert, sondern nur zum Verständhis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung v</li></ul>							
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen 19/04/2002	Recherchenberichts				
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter					
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Coppieters, C							

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 01/12825

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
US 5572173	Α	05-11-1996	JP JP	7226651 A 7226652 A	22-08-1995 22-08-1995
US 4317093	Α	23-02-1982	CA JP	, 1153077 A1 55137712 A	30-08-1983 27-10-1980